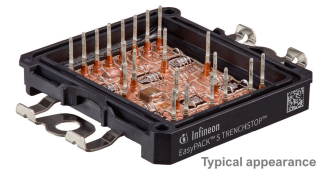


## Final datasheet

### EasyPACK™ 模块 带有温度检测 NTC

#### 特性

- 电气特性
  - $V_{CES} = 1200\text{ V}$
  - $I_{C\text{nom}} = 35\text{ A} / I_{CRM} = 70\text{ A}$
  - 低开关损耗
  - 低  $V_{CESat}$
  - 沟槽栅 IGBT4
  - 沟槽栅 IGBT7
  - $V_{CESat}$  带正温度系数
  - 可以从下面链接寻找适合的英飞凌驱动 IC <https://www.infineon.com/gdfinder>
- 机械特性
  - 低热阻的三氧化二铝  $\text{Al}_2\text{O}_3$  衬底
  - 高电流压接管脚
  - PressFIT 压接技术
  - 集成的安装夹使安装坚固
  - 集成 NTC 温度传感器



#### 可选应用

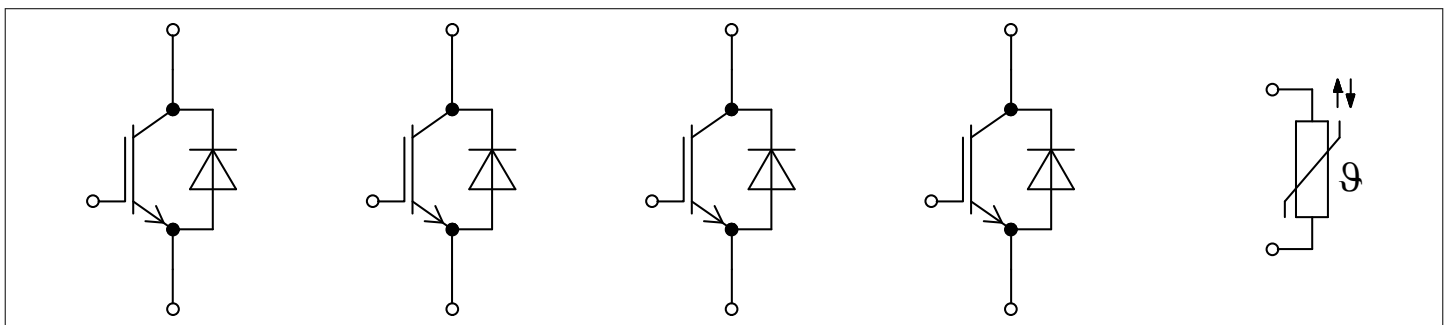
- 汽车应用
- PTC 加热器
- 混合动力汽车
- 模块针对阻容载

#### 产品认证

- Qualified according to AQC 324, release no.: 03.1/2021

#### 描述

Final datasheet



## 内容

	描述.....	1
	特性.....	1
	可选应用.....	1
	产品认证.....	1
	内容.....	2
<b>1</b>	<b>封装.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>IGBT, T1.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>IGBT, T2-T4.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Diode, D1-D4.....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	负温度系数热敏电阻.....	7
<b>6</b>	特征参数图表.....	8
<b>7</b>	电路拓扑图.....	15
<b>8</b>	封装尺寸.....	16
<b>9</b>	模块标签代码.....	17
	修订历史.....	18
	免责声明.....	19

## 1 封装

## 1 封装

表 1 绝缘参数

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
绝缘测试电压	$V_{ISOL}$	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$ , $t = 1 \text{ min}$	4.0	kV
NTC 绝缘测试电压	$V_{ISOL(NTC)}$	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$ , $t = 1 \text{ min}$	1.0	kV
内部绝缘		基本绝缘 (class 1, IEC 61140)	$Al_2O_3$	
相对电痕指数	$CTI$		600	
相对温度指数 (电)	$RTI$	封装	200	°C

表 2 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
杂散电感, 模块	$L_{sCE}$			10		nH
模块引线电阻, 端子-芯片	$R_{CC'+EE'}$	$T_H = 25 \text{ °C}$ , 每个开关		2.6		mΩ
储存温度	$T_{stg}$		-40		125	°C
Mounting force per clamp	$F$		20		30	N
重量	$G$			10		g

注: 单引脚到50A的电流耐受值受限于引脚与PCB设计及其散热条件之间的相互作用

## 2 IGBT, T1

表 3 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
集电极-发射极电压	$V_{CES}$		$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1200	V
连续集电极直流电流	$I_{CDC}$	$T_{vj \max} = 175 \text{ °C}$	$T_H = 80 \text{ °C}$	50	A
集电极重复峰值电流	$I_{CRM}$	$t_p$ 受限于 $T_{vj \text{ op}}$		100	A
栅极-发射极峰值电压	$V_{GES}$			±20	V

表 4 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位	
			最小值	典型值	最大值		
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE \text{ sat}}$	$I_C = 50 \text{ A}$ , $V_{GE} = 15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1.50	1.80	V	
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	1.64			
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	1.72			
栅极阈值电压	$V_{GEth}$	$I_C = 1.27 \text{ mA}$ , $V_{CE} = V_{GE}$ , $T_{vj} = 25 \text{ °C}$		5.15	5.80	6.45	V

(待续)

表 4 (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
栅极电荷	$Q_G$	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CC} = 600 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		0.92		$\mu\text{C}$
内部栅极电阻	$R_{Gint}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		0		$\Omega$
输入电容	$C_{ies}$	$f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$		11.1		nF
反向传输电容	$C_{res}$	$f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$		0.039		nF
集电极-发射极截止电流	$I_{CES}$	$V_{CE} = 1200 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$			3	$\mu\text{A}$
栅极-发射极漏电流	$I_{GES}$	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = 20 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$			100	nA
开通延迟时间(感性负载)	$t_{don}$	$I_C = 50 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V},$ $V_{GE} = 15 \text{ V}, R_{Gon} = 5.1 \Omega$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0.046		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	0.048		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	0.049		
上升时间(感性负载)	$t_r$	$I_C = 50 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V},$ $V_{GE} = 15 \text{ V}, R_{Gon} = 5.1 \Omega$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0.035		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	0.041		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	0.042		
关断延迟时间(感性负载)	$t_{doff}$	$I_C = 50 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V},$ $V_{GE} = 15 \text{ V}, R_{Goff} = 5.1 \Omega$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0.241		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	0.330		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	0.370		
下降时间(感性负载)	$t_f$	$I_C = 50 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V},$ $V_{GE} = 15 \text{ V}, R_{Goff} = 5.1 \Omega$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0.128		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	0.210		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	0.271		
开通损耗能量(每脉冲)	$E_{on}$	$I_C = 50 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V},$ $L_\sigma = 15 \text{ nH}, V_{GE} = 15 \text{ V},$ $R_{Gon} = 5.1 \Omega, di/dt =$ $1030 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	3		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	3.04		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	3.13		
关断损耗能量(每脉冲)	$E_{off}$	$I_C = 50 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V},$ $L_\sigma = 15 \text{ nH}, V_{GE} = 15 \text{ V},$ $R_{Goff} = 5.1 \Omega, dv/dt =$ $2700 \text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	3.3		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	5.25		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	6.45		
短路数据	$I_{SC}$	$V_{GE} = 15 \text{ V}, V_{CC} = 800 \text{ V},$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} * di/dt$	$t_p = 8 \mu\text{s},$ $T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	190		A
结-散热器热阻	$R_{thJH}$	每个 IGBT, $\lambda_{grease} = 5 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		0.789	0.883	K/W
允许开关的温度范围	$T_{vjop}$		-40		175	$^\circ\text{C}$

**注:** The electrical characterization was performed using an external discrete Schottky diode IDWD40G120C5 as a freewheeling diode. It should be noted that commutation takes place between this module and the external FWD.

### 3 IGBT, T2-T4

表 5 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
集电极-发射极电压	$V_{CES}$		$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1200	V
集电极电流	$I_{CN}$			35	A
连续集电极直流电流	$I_{CDC}$	$T_{vj\ max} = 150\text{ °C}$	$T_H = 65\text{ °C}$	30	A
集电极重复峰值电流	$I_{CRM}$	$t_p$ 受限于 $T_{vj\ op}$		70	A
栅极-发射极峰值电压	$V_{GES}$			$\pm 20$	V

表 6 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位	
			最小值	典型值	最大值		
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 35\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1.85	2.25	V	
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	2.15			
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	2.25			
栅极阈值电压	$V_{GETh}$	$I_C = 1.2\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ °C}$	5.25	5.80	6.35	V	
栅极电荷	$Q_G$	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CC} = 600\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.22		$\mu\text{C}$	
内部栅极电阻	$R_{Gint}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0		$\Omega$	
输入电容	$C_{ies}$	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		1.95		nF	
反向传输电容	$C_{res}$	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		0.1		nF	
集电极-发射极截止电流	$I_{CES}$	$V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$			4	$\mu\text{A}$
栅极-发射极漏电流	$I_{GES}$	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$				100	nA
开通延迟时间(感性负载)	$t_{don}$	$I_C = 35\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, V_{GE} = 15\text{ V}, R_{Gon} = 12\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.061		$\mu\text{s}$	
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	0.056			
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	0.055			
上升时间(感性负载)	$t_r$	$I_C = 35\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, V_{GE} = 15\text{ V}, R_{Gon} = 12\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.055		ns	
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	0.057			
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	0.058			
关断延迟时间(感性负载)	$t_{doff}$	$I_C = 35\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, V_{GE} = 15\text{ V}, R_{Goff} = 12\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.204		$\mu\text{s}$	
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	0.286			
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	0.307			
下降时间(感性负载)	$t_f$	$I_C = 35\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, V_{GE} = 15\text{ V}, R_{Goff} = 12\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.174		$\mu\text{s}$	
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	0.248			
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	0.274			

(待续)

表 6 (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
开通损耗能量 (每脉冲)	$E_{on}$	$I_C = 35\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V},$ $L_\sigma = 15\text{ nH}, V_{GE} = 15\text{ V},$ $R_{Gon} = 12\ \Omega, di/dt = 500$ $\text{A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	2.05		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	2.21		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	2.27		
关断损耗能量 (每脉冲)	$E_{off}$	$I_C = 35\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V},$ $L_\sigma = 15\text{ nH}, V_{GE} = 15\text{ V},$ $R_{Goff} = 12\ \Omega, dv/dt =$ $3100\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	2.19		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	3.41		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	3.84		
短路数据	$I_{SC}$	$V_{GE} = 15\text{ V}, V_{CC} = 800\text{ V},$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} * di/dt$	$t_p \leq 12\ \mu\text{s},$ $T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	160		A
			$t_p \leq 10\ \mu\text{s},$ $T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	130		
结-散热器热阻	$R_{thJH}$	每个 IGBT, $\lambda_{grease} = 5\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		0.841	0.931	K/W
允许开关的温度范围	$T_{vjop}$		-40		150	$^\circ\text{C}$

注: The electrical characterization was performed using an external discrete Schottky diode IDWD40G120C5 as a freewheeling diode. It should be noted that commutation takes place between this module and the external FWD.

## 4 Diode, D1-D4

表 7 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位	
反向重复峰值电压	$V_{RRM}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1200	V	
连续正向直流电流	$I_F$		10	A	
正向重复峰值电流	$I_{FRM}$	$t_p = 1\text{ ms}$	20	A	
I2t-值	$I^2t$	$t_p = 10\text{ ms}, V_R = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	24.5	$\text{A}^2\text{s}$
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	22.8	

表 8 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
正向电压	$V_F$	$I_F = 10\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1.72	2.10	V
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	1.59		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	1.56		

(待续)

表 8 (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
结-散热器热阻	$R_{thJH}$	每个二极管, $\lambda_{grease} = 5 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		2.82	3.30	K/W
允许开关的温度范围	$T_{vjop}$		-40		150	°C

## 5 负温度系数热敏电阻

表 9 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
额定电阻值	$R_{25}$	$T_{NTC} = 25 \text{ °C}$		10		k $\Omega$
$R_{100}$ 偏差	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100 \text{ °C}, R_{100} = 977 \text{ }\Omega$	-5		5	%
耗散功率	$P_{25}$	$T_{NTC} = 25 \text{ °C}$			20	mW
B-值	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3447		K
B-值	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3487		K
B-值	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3510		K

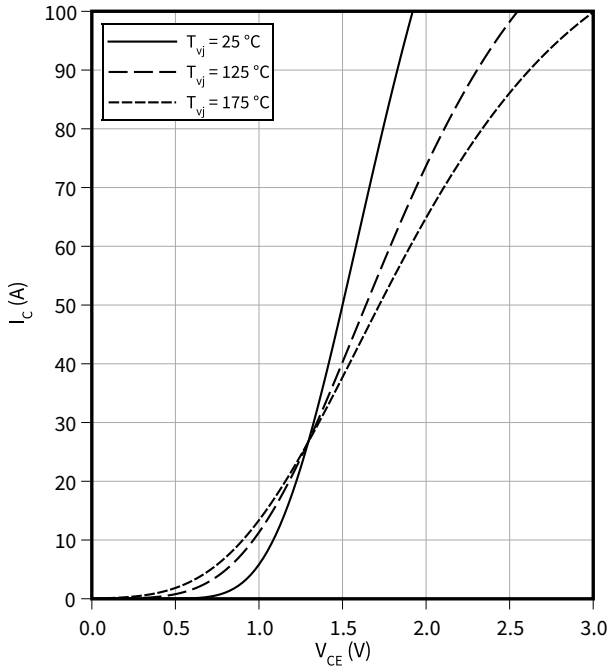
**注:** NTC 的具体参数分析请见 AN2009-10, 第 4 章

6 特征参数图表

输出特性 (典型), IGBT, T1

$I_C = f(V_{CE})$

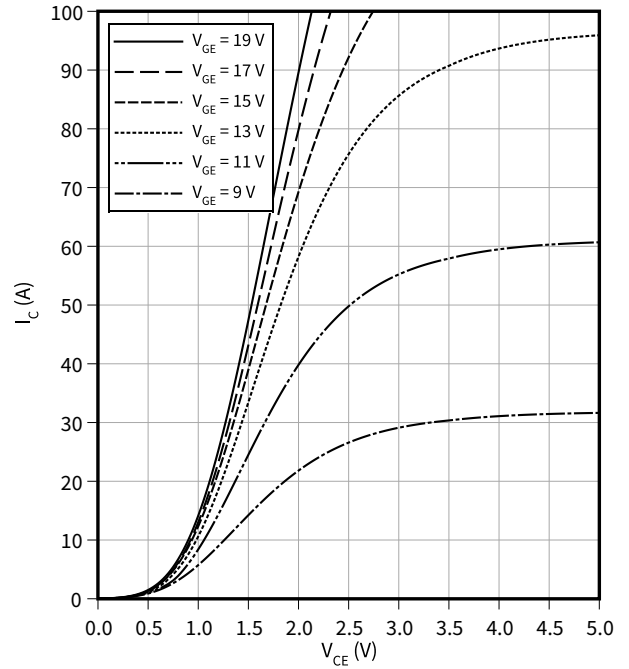
$V_{GE} = 15\text{ V}$



输出特性 (典型), IGBT, T1

$I_C = f(V_{CE})$

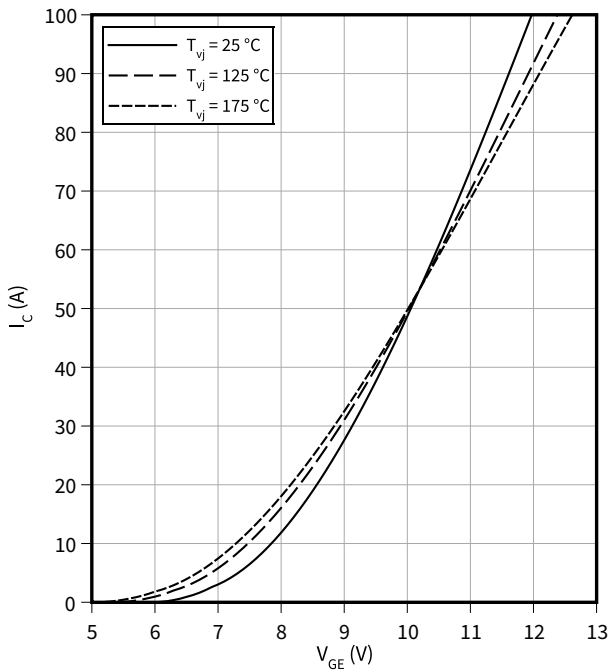
$T_{vj} = 175\text{ °C}$



传输特性 (典型), IGBT, T1

$I_C = f(V_{GE})$

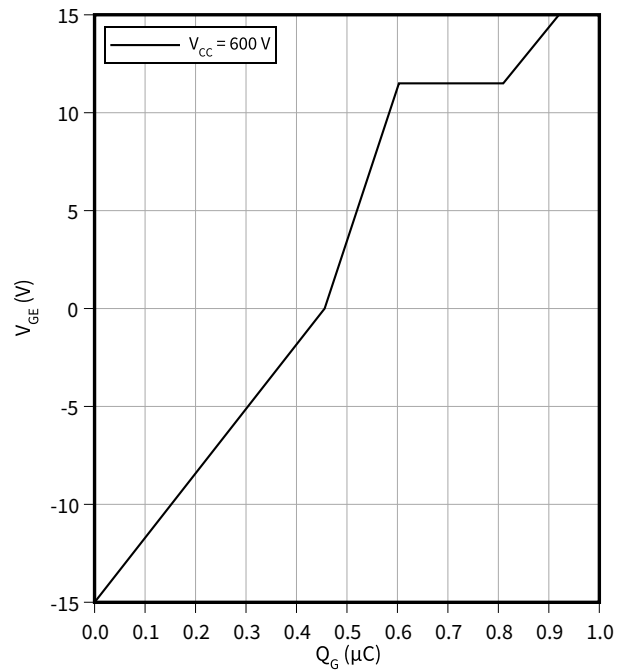
$V_{CE} = 20\text{ V}$



栅极电荷特性 (典型), IGBT, T1

$V_{GE} = f(Q_G)$

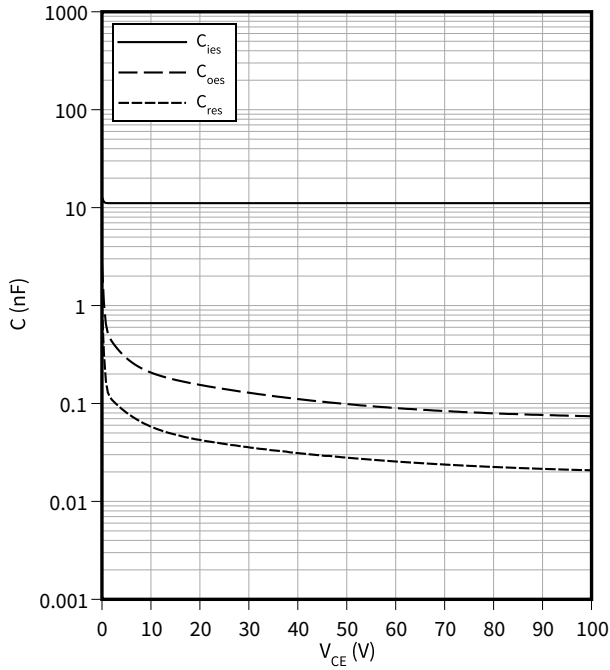
$T_{vj} = 25\text{ °C}, I_C = 50\text{ A}$



电容特性 (典型), IGBT, T1

$C = f(V_{CE})$

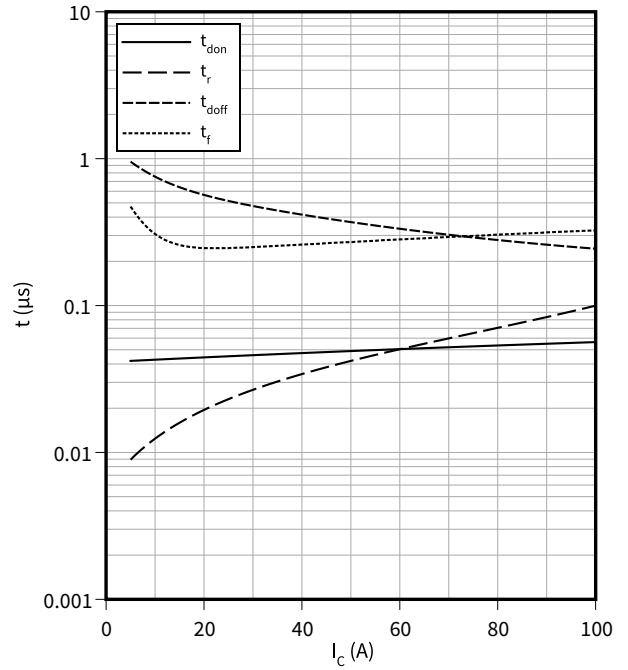
$f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



开关时间 (典型), IGBT, T1

$t = f(I_C)$

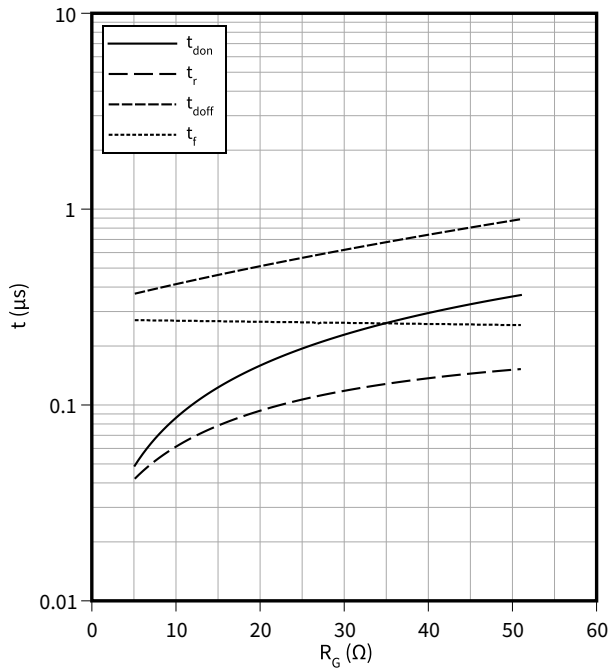
$R_{Goff} = 5.1 \text{ } \Omega, R_{Gon} = 5.1 \text{ } \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CC} = 600 \text{ V}$



开关时间 (典型), IGBT, T1

$t = f(R_G)$

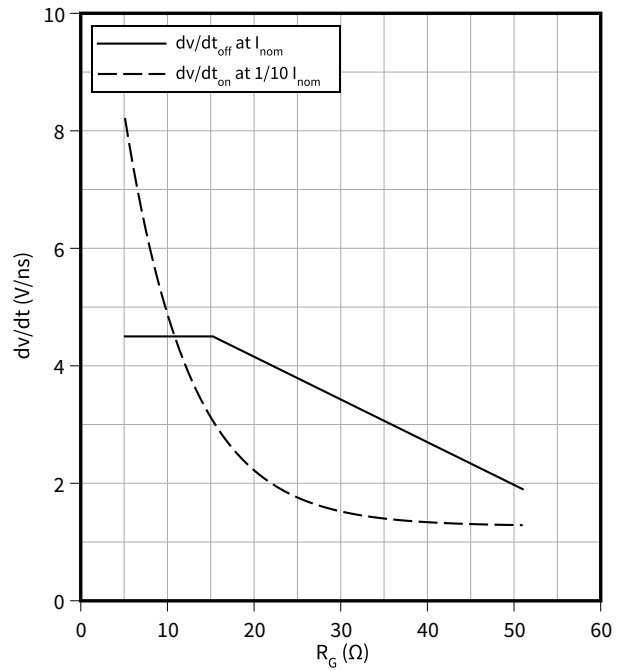
$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 50 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}$



电压变化斜率 (典型), IGBT, T1

$dv/dt = f(R_G)$

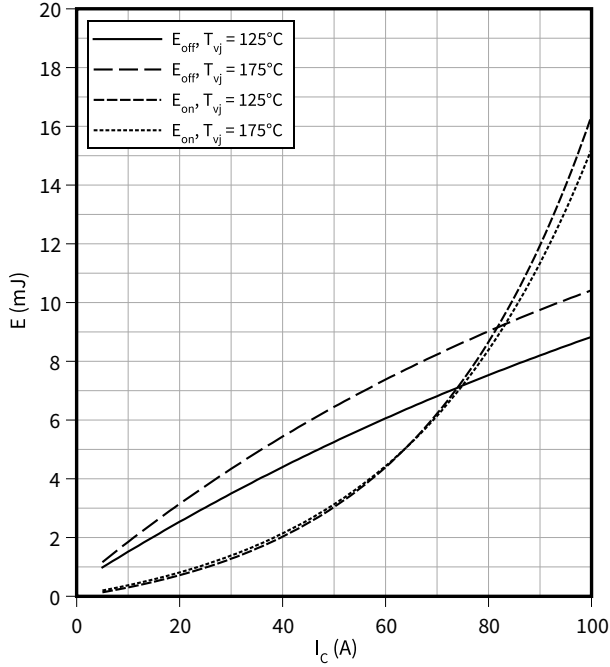
$I_C = 50 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



开关损耗 (典型), IGBT, T1

$E = f(I_C)$

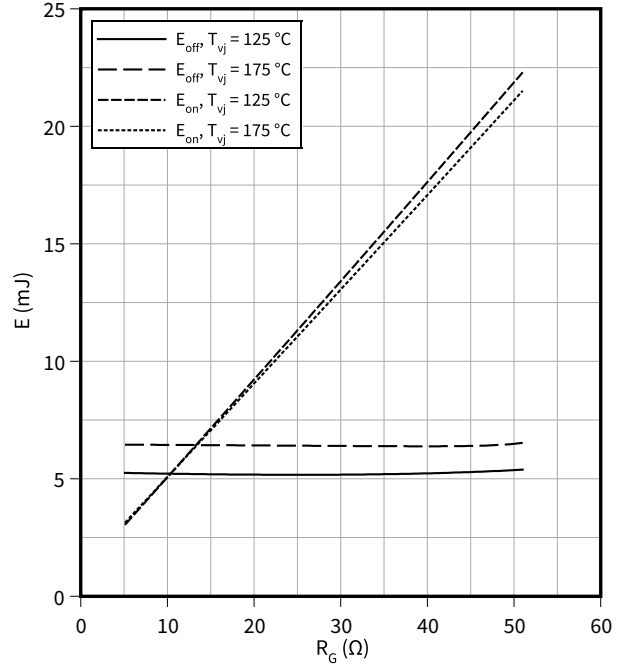
$R_{Goff} = 5.1 \Omega, R_{Gon} = 5.1 \Omega, V_{GE} = \pm 15 V, V_{CC} = 600 V$



开关损耗 (典型), IGBT, T1

$E = f(R_G)$

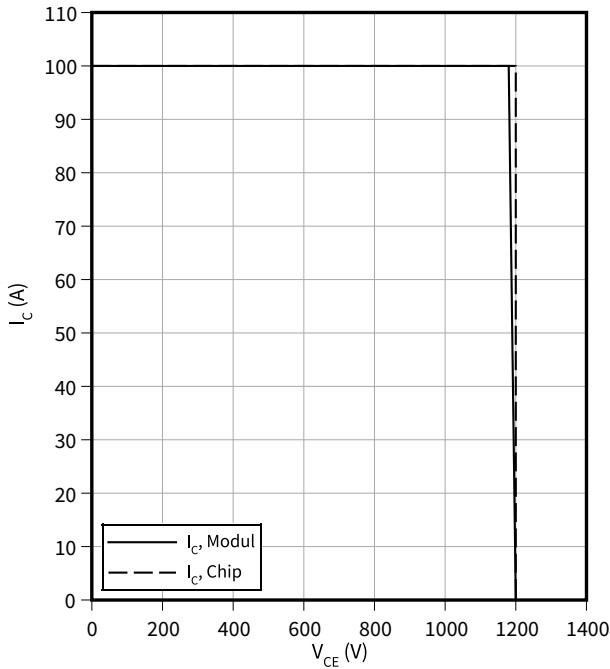
$V_{GE} = \pm 15 V, I_C = 50 A, V_{CC} = 600 V$



反偏安全工作区 (RBSOA), IGBT, T1

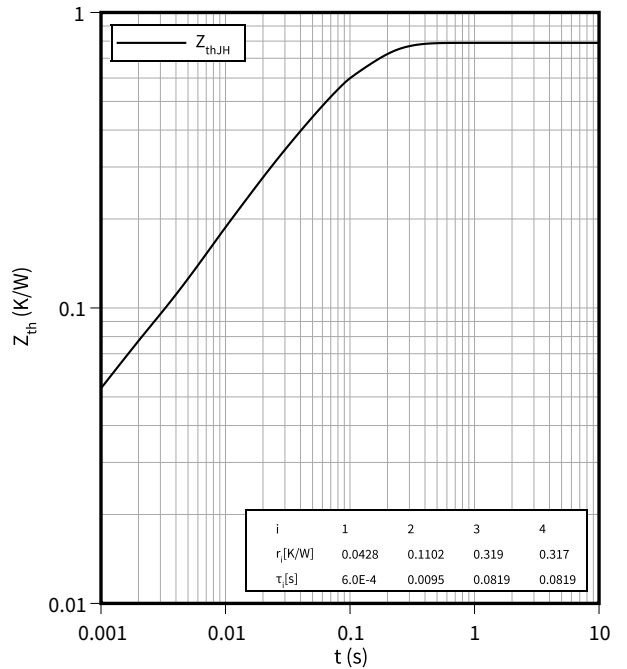
$I_C = f(V_{CE})$

$R_{Goff} = 5.1 \Omega, V_{GE} = \pm 15 V, T_{vj} = 175 \text{ °C}$



瞬态热阻抗, IGBT, T1

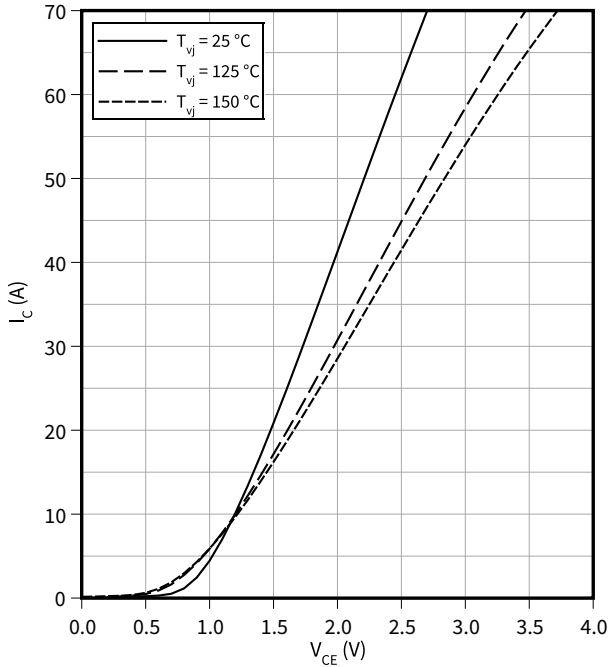
$Z_{th} = f(t)$



输出特性 (典型), IGBT, T2-T4

$I_C = f(V_{CE})$

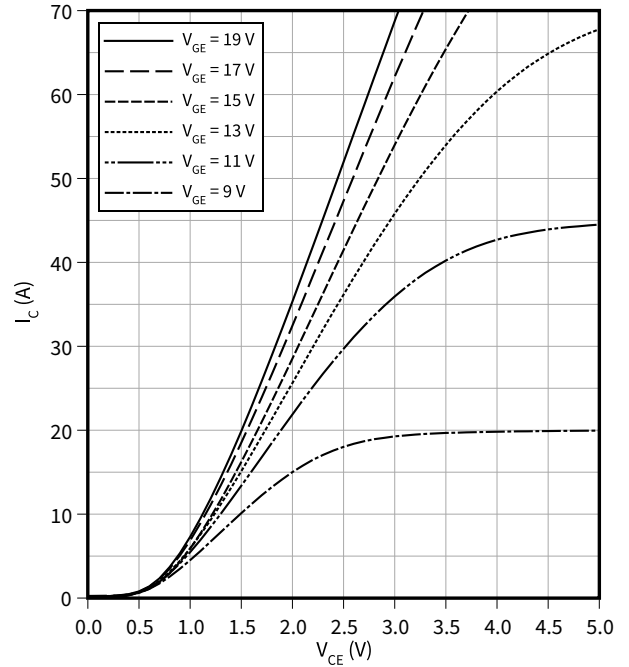
$V_{GE} = 15\text{ V}$



输出特性 (典型), IGBT, T2-T4

$I_C = f(V_{CE})$

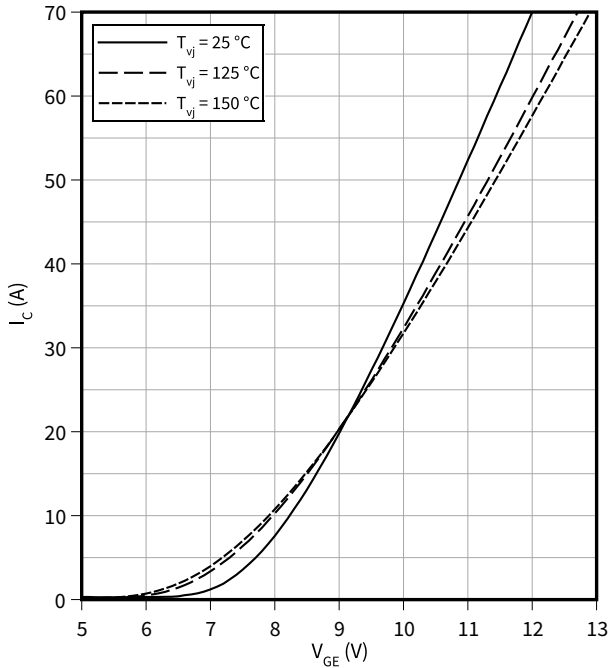
$T_{vj} = 150\text{ °C}$



传输特性 (典型), IGBT, T2-T4

$I_C = f(V_{GE})$

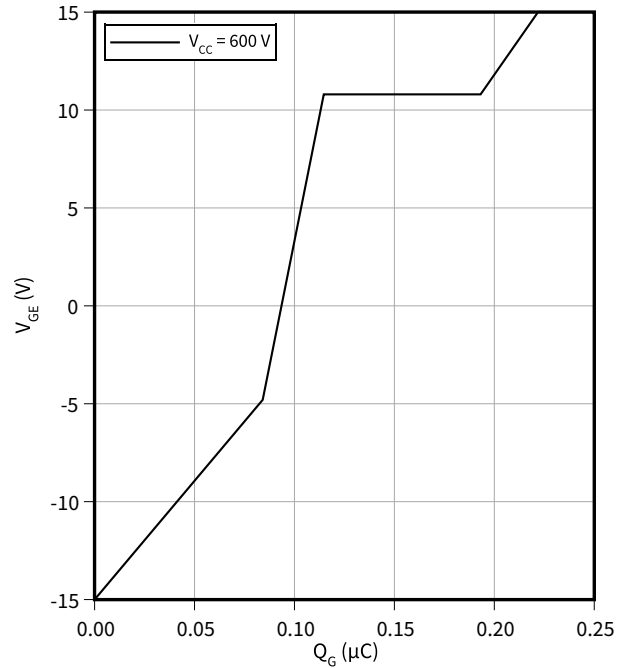
$V_{CE} = 20\text{ V}$



栅极电荷特性 (典型), IGBT, T2-T4

$V_{GE} = f(Q_G)$

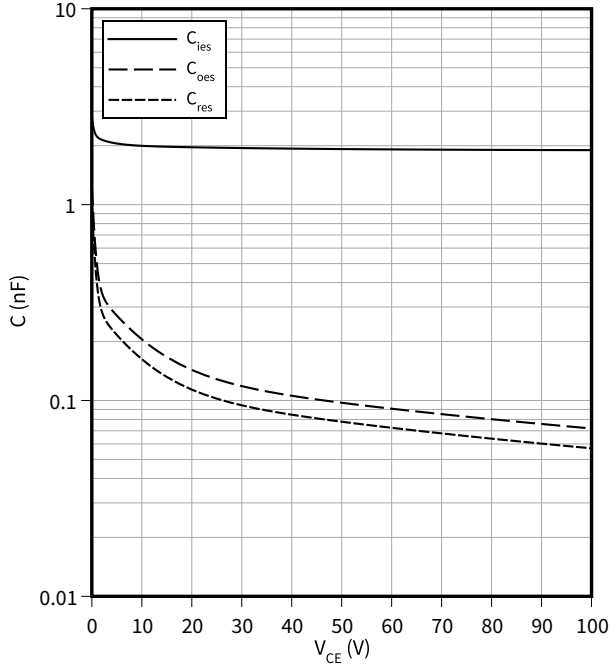
$I_C = 35\text{ A}, T_{vj} = 25\text{ °C}$



电容特性 (典型), IGBT, T2-T4

$C = f(V_{CE})$

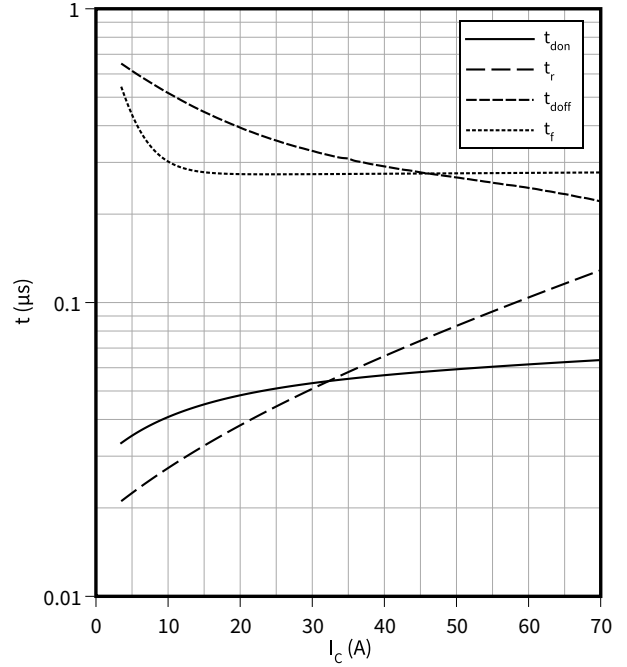
$f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



开关时间 (典型), IGBT, T2-T4

$t = f(I_C)$

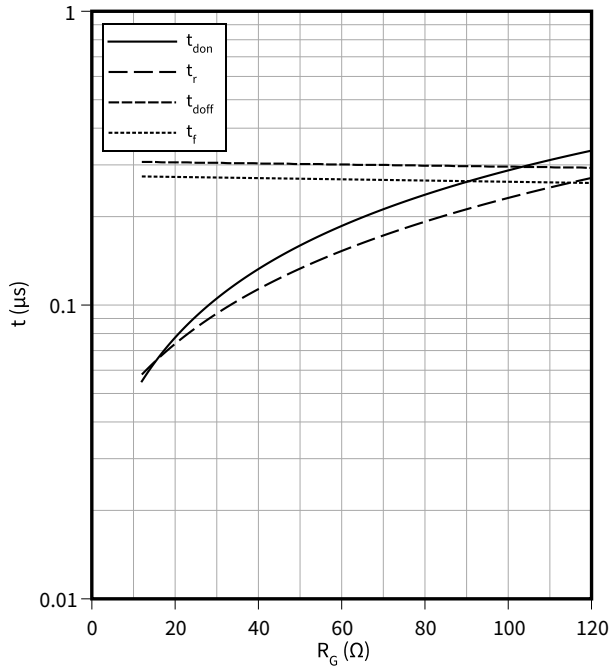
$R_{Goff} = 12 \text{ } \Omega, R_{Gon} = 12 \text{ } \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CC} = 600 \text{ V}$



开关时间 (典型), IGBT, T2-T4

$t = f(R_G)$

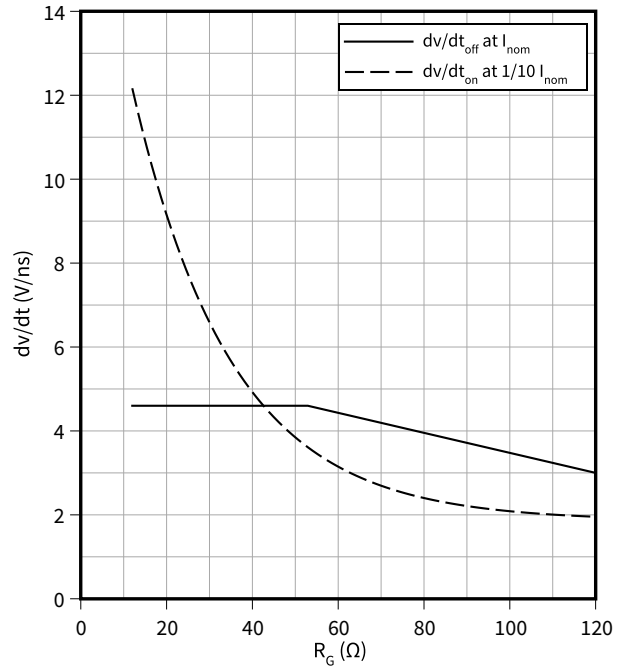
$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 35 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}$



电压变化斜率 (典型), IGBT, T2-T4

$dv/dt = f(R_G)$

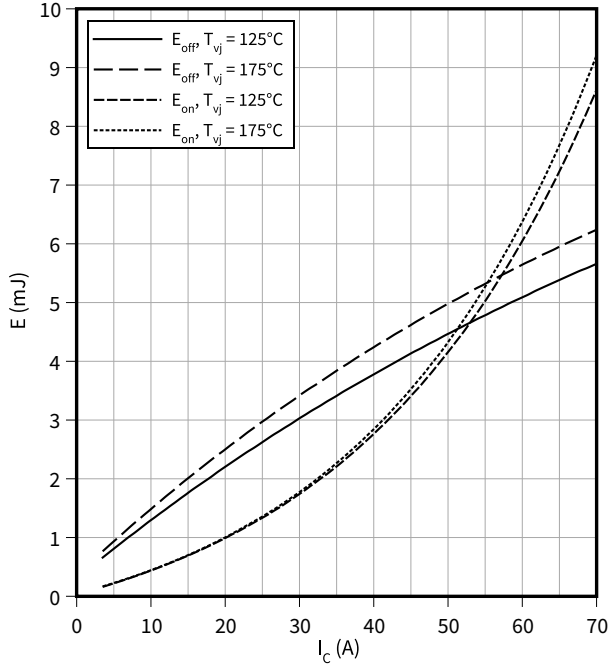
$I_C = 35 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



开关损耗 (典型), IGBT, T2-T4

$E = f(I_C)$

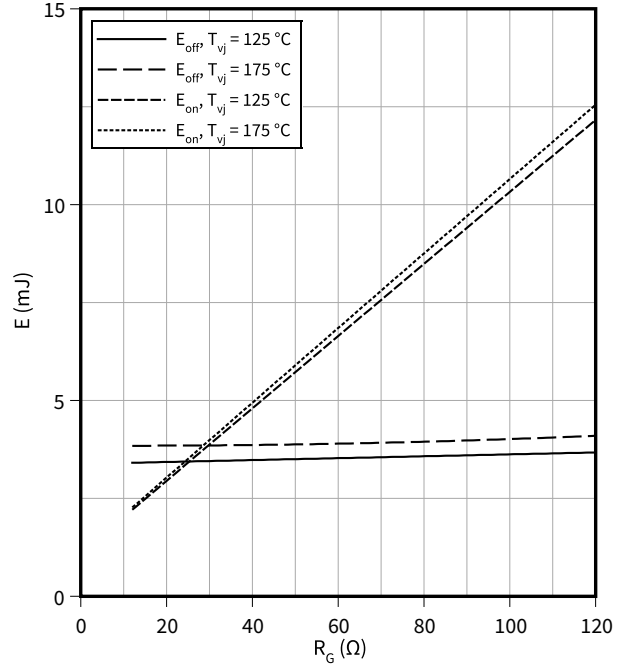
$R_{Goff} = 12 \Omega$ ,  $R_{Gon} = 12 \Omega$ ,  $V_{GE} = \pm 15 V$ ,  $V_{CC} = 600 V$



开关损耗 (典型), IGBT, T2-T4

$E = f(R_G)$

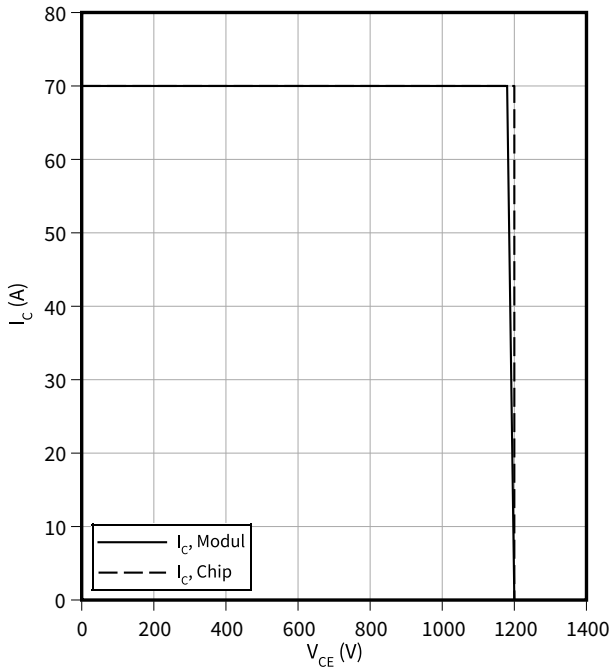
$V_{GE} = \pm 15 V$ ,  $I_C = 35 A$ ,  $V_{CC} = 600 V$



反偏安全工作区 (RBSOA), IGBT, T2-T4

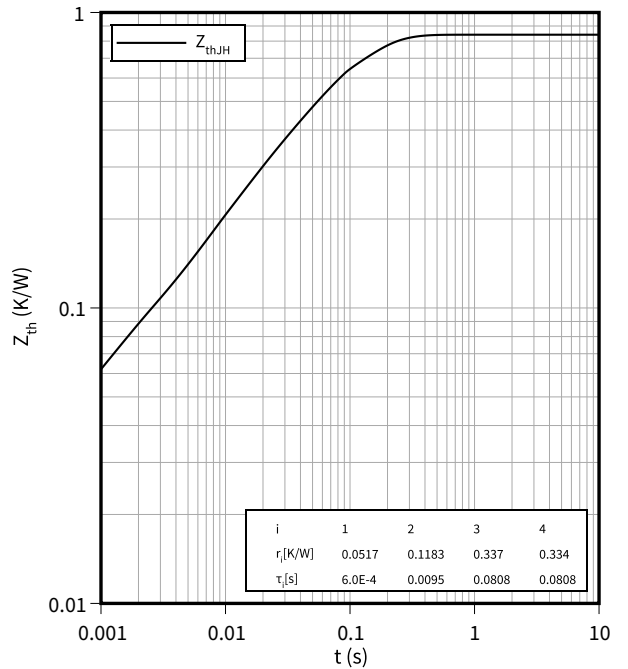
$I_C = f(V_{CE})$

$R_{Goff} = 12 \Omega$ ,  $V_{GE} = \pm 15 V$ ,  $T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$



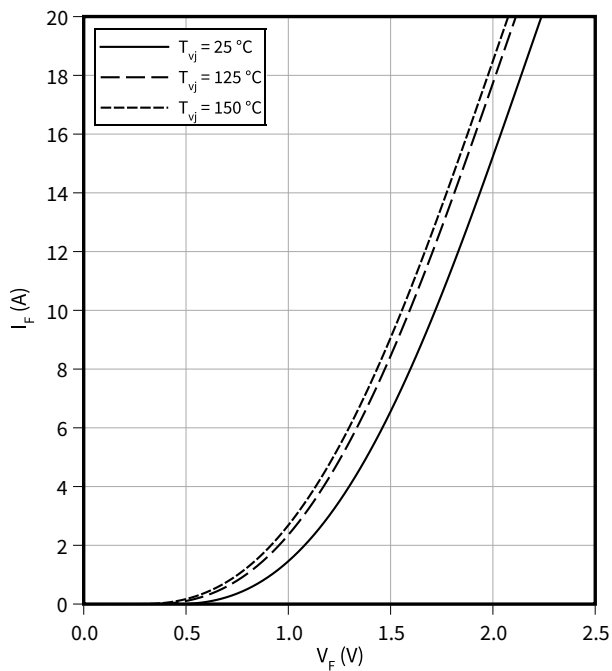
瞬态热阻抗, IGBT, T2-T4

$Z_{th} = f(t)$



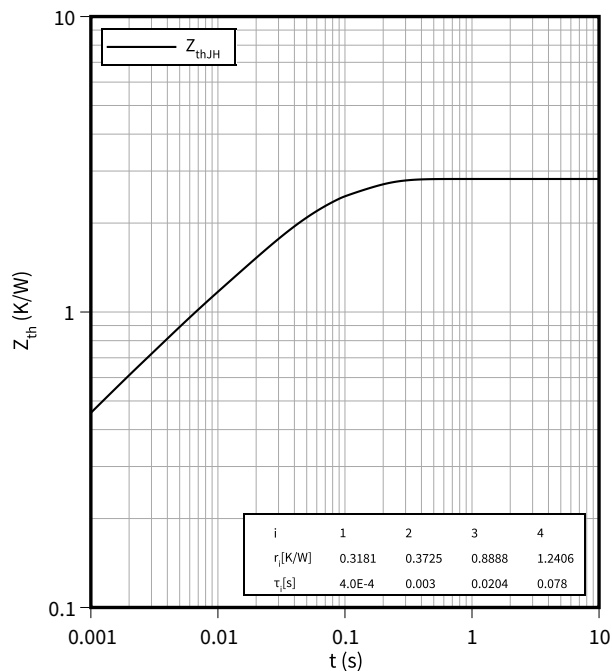
正向特性 (典型), Diode, D1-D4

$I_F = f(V_F)$



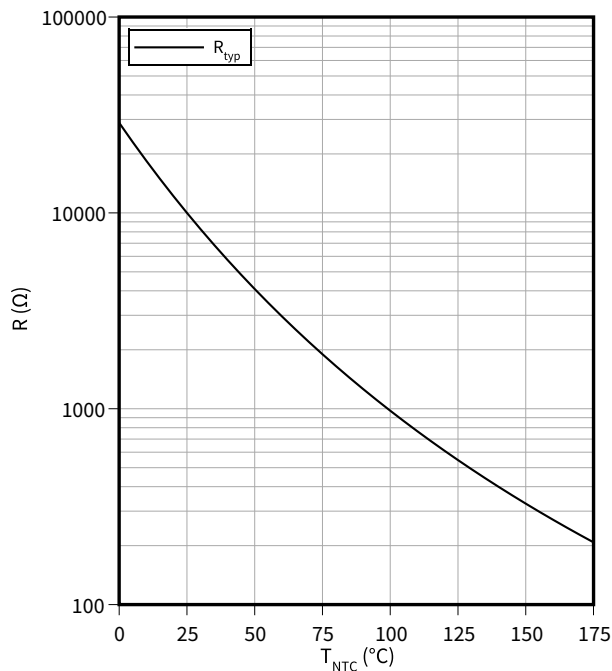
瞬态热阻抗, Diode, D1-D4

$Z_{th} = f(t)$



温度特性, 负温度系数热敏电阻

$R = f(T_{NTC})$



### 7 电路拓扑图

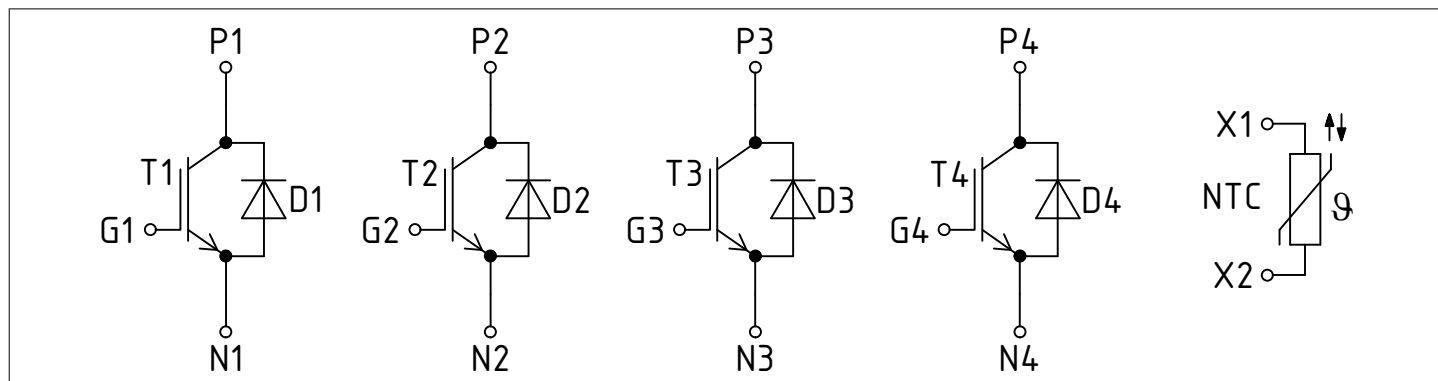


图 1

8 封装尺寸

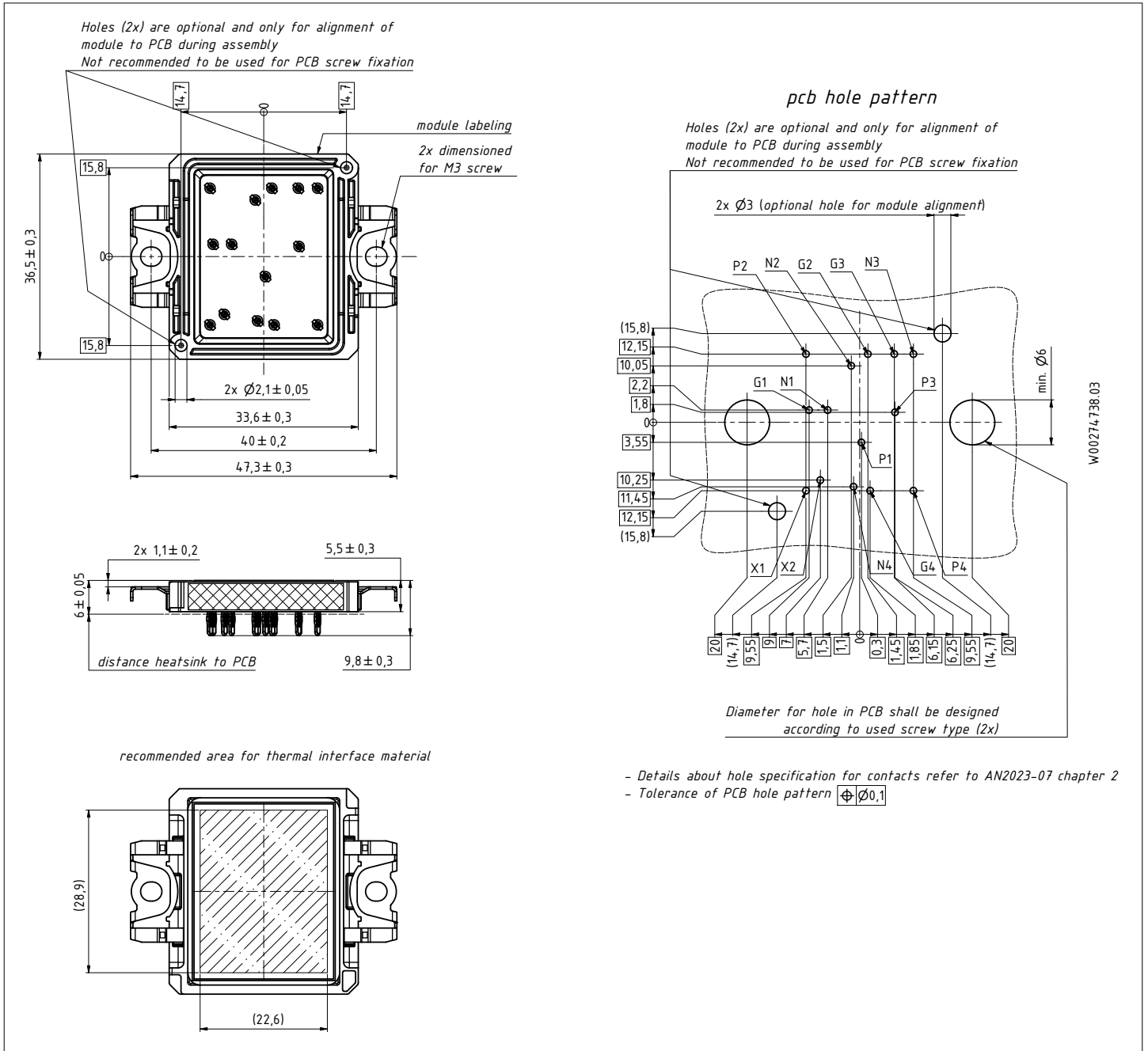


图 2

## 9 模块标签代码


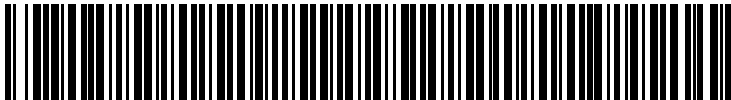
Module label code			
Code format	Data Matrix	Barcode Code128	
Encoding	ASCII text	Code Set A	
Symbol size	16x16	23 digits	
Standard	IEC24720 and IEC16022	IEC8859-1	
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 -5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 -21	15
	Date code (production week)	22 -23	30
Example	 		
	71549142846550549911530		71549142846550549911530

图 3

## 修订历史

修订版本	发布日期	变更说明
0.10	2025-11-13	Target datasheet
0.20	2026-03-03	Preliminary datasheet
1.00	2026-04-08	Final datasheet
1.01	2026-04-14	Correction of RTI

## Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

**Edition 2026-04-14**

**Published by  
Infineon Technologies AG  
81726 Munich, Germany**

**© 2026 Infineon Technologies AG  
All Rights Reserved.**

**Do you have a question about any  
aspect of this document?**

**Email: [erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)**

**Document reference  
IFX-ABM411-004**

## 重要提示

本文档所提供的任何信息绝不应被视为针对任何条件或者品质而做出的保证（质量保证）。

英飞凌对于本文档中所提及的任何事例、提示或者任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此排除。

此外，本文档所提供的任何信息均取决于客户履行本文档所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律要求、规范和标准。

本文档所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜于其预期的应用和针对该等应用而言本文档中所提供的信息是否充分自行予以评估。

## 警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后领域。